



电子元器件系列(中国.厦门) China.Xiamen
www.rf-china.com RF-Micom co.,Ltd

Email:sales@rf-china.com

Telephone:0086-592-5713956 Fax:5201617

FET、IPD、GaAs MMIC

■ 功率 F-MOS FET Line up ($V_{GS} = 10\text{ V}$)

V_{DS} (V) I_D (A)	60	100	150	200	230	250	350	400	450	500	600	800
0.5								2SK3124 U ₂₃ 2SK3329 92NL ₂₃ 2SK3383 小功率 ₂₃				
2				2SJ0582* U _{2.0}								2SK3047 220D _{7.0}
2.5				2SK3277 U _{1.7}						2SK3045 220D _{4.0}		
3			2SK3035 U _{1.1}								2SK3048 220D _{2.5}	2SK3636 220D _{4.0}
5	2SK3022 U _{0.135}								2SK3043 220D _{1.3}			
7									2SK3044 220D _{0.75}	2SK3046 220D _{1.0}		
8		2SK3030 U _{0.23}										
15		2SK3031 U _{0.135} 2SK3268 U _{0.1}									2SK3318 TOP-3F _{0.46}	
20	2SK3024 U _{50m}				2SK3628 TOP-3F _{85m} 2SK3731 220C _{85m}	2SK3494 220C _{105m}	2SK3193 TOP-3F _{0.15}					
25		2SK3269 220C _{0.1}										
30	2SK3025 U _{40m}		2SK3723 220C _{46m}		2SK3559 TOP-3F _{74m} 2SK3560 220C _{74m}	2SK3192 TOP-3F _{68m}						
50				2SK3637 TOP-3E _{40m}	2SK3652 TOP-3E _{40m}							

※※ 表中的型号下部为封装缩写、并且 Small numerical Value 表示 $R_{DS(on)}$ (Ω) 的最大值。

(封装缩写) 92NL = TO-92NL-A1(D46) 220D: TO-220D-A1(D63), U: U-G1/U-G2(D53/D54), 220C: TO-220C-G1(D62)

※Pch MOS FET(2SJ省略了反信号)

■ 功率 F-MOS FET

封装 (封装 No.)						绝对最大额定 (T _a = 25 °C)			电气特性 (T _a = 25 °C)				
N-A1 (D57)	TO-220C-G1 (D62)	TO-220D-A1 (D63)	TOP-3F-A1 (D69)	TOP-3E-A1 (D68)	U-G1/U-G2 (D53/D54)	V _{DSS} (V)	V _{GSS} (V)	I _b (A)	R _{DS(on)} max. (Ω)	Y _{fs} typ. (S)	t _{on} typ. (ns)	t _f typ. (ns)	t _{d(off)} typ. (ns)
2SK2339					2SJ0582	-200	± 20	2	2	2.0	27	25	50
					2SK3022	60		5	0.135	—	—	—	—
					2SK3024			20	0.05	—	—	—	—
					2SK3025			30	0.04	—	—	—	—
						80 ± 10	± 15	10	0.23	5.5	500	900	1900
					2SK3030	100	± 20	8	0.23	—	—	—	—
					2SK3031			15	0.135	—	—	—	—
					2SK3268				25	0.1	11	15	35
	2SK3269					150	± 20	3	1.1	2.2	—	—	—
					2SK3035			30	0.046	16	33	68	245
	2SK3723				2SK3277	200	± 20	2.5	1.75	1.3	53	60	200
			2SK3628	2SK3637		230	± 30	50	0.04	30	175	140	390
								20	0.085	14	61	36	220
	2SK3731								0.085	14	31	47	214
			2SK3559					30	0.074	16	78	25	217
	2SK3560					250	± 30	50	0.074	16	39	45	227
				2SK3652					0.04	34	205	145	470
	2SK3494							20	0.105	14	36	29	184
			2SK3192					30	0.068	15	160	130	330
			2SK3193			350	± 20	20	0.15	12	115	95	340
					2SK3124	400		0.5	23	0.16	t _{d(on)} 11	40	50
	2SK3043					450		5	1.3	2.5	70	35	80
	2SK3044							8	0.75	5	70	50	150
						500	± 30	2.5	4.0	1.5	40	30	55
								8	1.0	5	100	60	140
								3	2.5	2.5	t _{d(on)} 15	40	90
			2SK3318			600		15	0.46	10	95	70	310
						800		2	7.0	1.1	35	25	60
		2SK3047						3	4.0	2.4	t _{d(on)} 35	160	50

Δ: 暂定规格

FET、IPD、GaAs MMIC

■ 功率晶体管阵列 (F-MOS FET)

用途	型号	绝对最大额定 (T _C = 25 °C)				电气特性 (T _a = 25 °C)					封装	
		V _{DSS} (V)	V _{GSS} (V)	I _D (A)	P _D (W)	R _{DS(on)} max. (mΩ)	Y _{fs} typ. (S)	t _{on} typ.* (ns)	t _f typ. (ns)	t _{d(off)} typ. (ns)		
无接点 Solenoid 驱动 / 马达驱动 控制产品 开关电源	PUB4753	100 ± 5	± 20	± 3	15	450/600◆	4	0.2	0.3	1.5	SIP10-A1	D72
	PUB4701	150*	± 20*	± 6*	15*	0.6*/0.7*◆	5.3*	10*	8.5*	290*		
	PUB4702	35 ± 10*	± 15*	± 1*		380/680*◆	1*	120*	390*	800*		

*: T_a=25 °C ◆: 低电压驱动 (V_{GS} = 4V) 额定

■ 硅结型 FET

用途	封装 (封装 No.)							绝对最大额定 (T _a = 25 °C)		电气特性 (T _a = 25 °C)	
	SSSMini3-F1 (D4)	SSMini3-F2 (D9)	SMini3-G1 (D16)	MiniT3-F1 (—)	Mini3-G1 (D25)	NS-A1/NS-B1 (D47/D48)	TO-92-A1 (D42)	V _{DSS} *V _{GDS} (V)	I _D (mA)	NV *NF max. *typ. (mV)	I _{DSS} max. (mA)
通用 低频放大	—	—	2SJ0364	—	2SK1103 2SJ0163	2SK1104 2SJ0164	—	*-65 *65	20 -20	—	6 -6
通用	—	2SK2593J	2SK0662 2SK0663	—	2SK0198	—	2SK0301	V _{GDO} -30 V _{GDO} -55 V _{GDO} -55	20 30 30	*60 **2.5 dB **0.5 dB	12 20 20
电容话筒	2SK3372 2SK3426	—	—	2SK1860 2SK3427	2SK0123	—	—	20 20	2 2	0.004 0.01	0.4 0.4
红外传感器用	Δ 2SK3396	2SK2380J	—	—	2SK1842 2SK2751	—	—	V _{GDO} -40 *-40	1 10	C _{iss} *1 pF —	0.2 4.7

Δ: 暂定规格

■ 硅 MOS FET

● 小信号用

用 途	结 构	型 号	绝对最大额定 (T _a = 25 ℃)				电气特性 (T _a = 25 ℃)				封 装		
			V _{DS} *V _{DSS}	V _{GSO}	I _D	P _D	Y _{fs} min. *typ. (mS)	R _{DS(on)} max. *typ. (Ω)	t _{on} max. *typ. (ns)	t _{off} max. *typ. (ns)			
			(V)	(V)	(A)	(mW)						No.	
数字 / 模拟 开关	N-ch P-ch	2SK0601	80	20	0.5	1 000	*300	*2	*15	*20	MiniP3-F1	D30	
		2SK0614				750					TO-92-A1	D42	
		2SK0655	50	8	0.1	200	20	50	10	20	NS-A1/NS-B1	D47/ D48	
		2SK0656				1 000			1 000				
		2SK0664				20			40	10	20	SMini3-G1	D16
		2SK0665								1 000	1 000		
		2SK1228※	50	10	0.05	150	*39	*27	2 000	2 000	Mini3-G1	D25	
		2SK1374※									SMini3-G1	D16	
		2SK3539		± 7	0.1		20	*8	*200	*200	SSMini3-F1	D8	
		Δ 2SK3546J	SSSMini3-F1			D4							
		Δ 2SK3547	MiniP3-F1			D30							
		2SK2211	30	± 20	1	1 000	500	*0.48	*12	*160	MiniP3-F1	D30	
		2SK3064	*30		0.1	15	30*	*150	*35	SMini3-G1	D16		
		2SJ0536	*-30		- 0.1	8	50*	*100	*25				

Δ: 暂定规格 *: 2.5 V 驱动

FET、 IPD、 GaAs MMIC

■ IPD (Intelligent Power Device)

关于 IPD 产品,正在探讨刊载内容,请见谅。

FET、IPD、GaAs MMIC

■ GaAs MMIC

● 移动通信用 GaAs MMIC

Bolock	型 号	功 能	RF 特性 (typ.)	用 途	封 装	No.
低噪声放大器	GN01087B	单芯片前端 V _{DD} = 3.4 V, I _{DD} = 5.0 mA, f = 1.9 GHz	CG: 20 dB NF: 4.0 dB	PHS	Mini6-G1	D28
	GN01096B	附带增益控制 LNA V _{DD} = 2.9 V, I _{DD} = 6.5 mA, f = 0.8 GHz	PG: 15 dB NF: 1.4 dB	CDMA	SMini6-G1	D21
驱动器放大器	GN01106B	附带增益控制 2 级放大器 V _{DD} = 2.8 V, I _{DD} = 30.0 mA, f = 0.8 GHz	PG: 29 dB DR: 48 dB	CDMA	SMini6-G1	D21
	GN01140B	附带增益控制 2 级放大器 V _{DD} = 2.8/3.5 V, I _{DD} = 25.0 mA, f = 0.8 GHz	PG: 34 dB DR: 46 dB	PDC		
	GN01157S	附带增益控制 2 级放大器 V _{DD} = 2.8/3.5 V, I _{DD} = 35.0 mA, f = 1.5 GHz	PG: 30 dB DR: 48 dB			
	GN01165S	附带增益控制 2 级放大器 V _{DD} = 2.8/3.5 V, I _{DD} = 33 mA, f = 1.5 GHz	PG: 24 dB DR: 47 dB			
	GN01180S	附带增益控制 2 级放大器 V _{DD1} = 2.8 V, V _{DD2} = 3.5 V, f = 1.5 GHz	PG: 29.5 dB DR: 39 dB			CQF6-N1
天线开关	GN04017N	大功率 SPDT 开关 V _{DD} = 3.0 V, I _{DD} = 10 μA, f = 0.8 GHz	LOSS: 0.2 dB ISO: 23 dB	CDMA	SMini6-G1	D21
	GN04022N	大功率 SPDT 开关 V _{DD} = 3.0 V, I _{DD} = 10 μA, f = 2.0 GHz	LOSS: 0.25 dB ISO: 23 dB	W-CDMA		
	GN04028N	大功率 DPDT 开关 V _{DD} = 3.0 V, I _{DD} = 10 μA, f = 0.8 GHz		CDMA+GPS		
	GN04033N	大功率 SPDT 开关 V _{DD} = 3.0 V, I _{DD} = 10 μA, f = 1.5 GHz	LOSS: 0.2 dB ISO: 28 dB	PDC		
	GN04038N	大功率 SPDT 开关 V _{DD} = 3.0 V, I _{DD} = 10 μA, f = 0.8/1.5 GHz	LOSS: 0.18 dB ISO: 23 dB			
	GN04042N	大功率 SP3T 开关 V _{ctl} = 0/3 V, f = 0.8/1.9 GHz	LOSS: 0.27 dB ISO: 30 dB (PCS) 22 dB (CDMA)	CDMA/PCS/ GPS	CQF12-N1	D84